

# 广东德瓷技术有限公司

Dc-piezo Technology Co.,LTD.

# 产 品 规 格 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Tel:0755-8327 8880

E-mail : [13798552005@qq.com](mailto:13798552005@qq.com)

Fax:0755-8327 9488

Website : [www.dc-piezo.com](http://www.dc-piezo.com)

客户名称 (CustomerName) :					
产品名称 (Product Name) :			压电陶瓷晶片		
产品型号 (Product Type) :			DCCP-P4-Φ28-2.1M		
制订日期 (Dateprepared) :					
<b>供应商确认</b> Paizhou Approv			<b>客户确认</b> Customer's Approval		
制 订 (签章)	核 准 (签章)	业 务 部 (签章)	确 认 人 (签章)	核 准 (签章)	采 购 部 (签章)

广东德瓷技术： 深圳市坪山区马峦街道沙坐社区沙宝路 6 号厂房

## 1 主题内容和适用范围 Subject and Scope

### 1.1 主题内容 Subject

本规格书规定了压电陶瓷环 DCCP-P4-Φ28-2.1M 的技术要求和包装规范。

This specification provides the technical requirements, and packaging specifications for piezoelectric ceramic ring DCCP-P4-Φ28-2.1M

### 1.2 适用范围 Sphere of Application

本规格书适用于压电陶瓷环 DCCP-P4-Φ28-2.1M 最终交付要求的描述。

The specification specified the applications on final delivery requirements of the piezoelectric ceramic product DCCP-P4-Φ28-2.1M. After customers recognize this specification is the basis for test of these products.

## 2 产品型号 Product Model

DCCP-P4-Φ28-2.1M

## 3 命名规则 Naming Rules

型号 Model: 

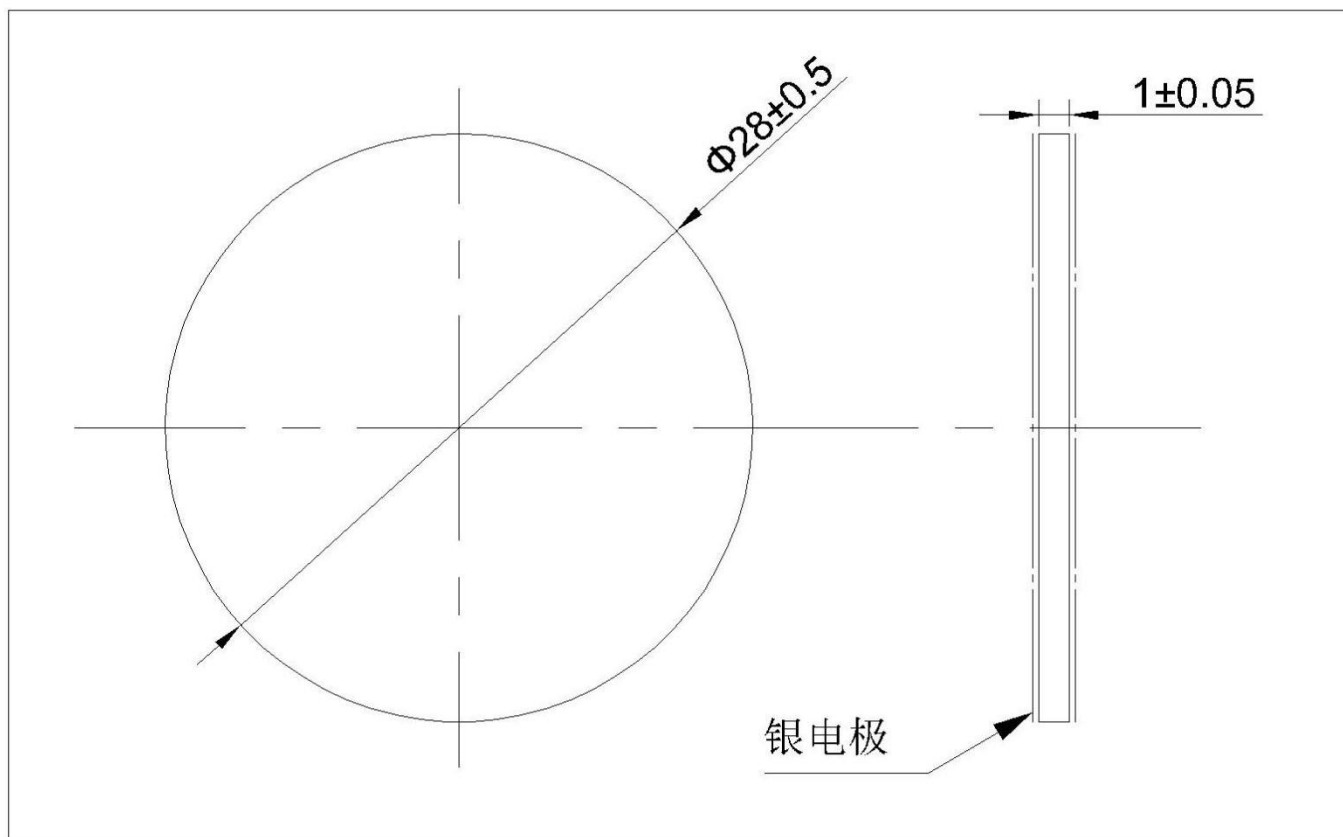
DC	C	P	-	P4	Φ 28*1	-	S	1
----	---	---	---	----	--------	---	---	---

① ② ③ ④
⑤
⑥ ⑦

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| ① 德瓷技术代码       | Deci Code                          |
| ② C:晶片; A:雾化片  | C: Ceramic Chip; A: Atomizer plate |
| ③ P:平板片; H 中孔片 | P: Plate; H: Hole                  |
| ④ 材料名称         | Material name                      |
| ⑤ 尺寸           | Dimensions                         |
| ⑥ 电极形状代码       | Electrode shape code               |
| ⑦ 电极特征代码       | Protective layer code              |

## 4 外观要求 Appearance Requirements

### 4.1 外形尺寸(mm)Dimension



#### 4.2 外观要求

**银层**

电极面上无明显露瓷、磨伤及划伤;电极边缘不发黄;电极正负极标注正确

**瓷体**

无裂纹,无明显缺瓷、崩边等损伤

**Silver layer**

no exposure of porcelain, grinding hurt or scratch on electrode surface

**Porcelain body**

no cracks, intact porcelain, chipping and other damage

## 5 性能参数 Performance Parameters

编号	参数	符号	单位	技术要求
1	机电耦合系数	Kp	%	≥53%
2	介电损耗	$\tan \delta$	%	≤0.5%
3	静态容量	C	pF	7000±5%
4	厚度频率	FR	KHZ	2100±100
5*	居里温度	Tc	℃	≥300 ℃
6*	机械品质因素	Qm	--	≥500
7*	密度	p	kg/m <sup>3</sup>	7.45×10 <sup>3</sup>
8*	频率常数	N	Hz. m	2200±5%

注：1. 测试温度为 25±5℃

2. 表中编号 1-3 为晶片性能参数，4-7 为材料性能参数；

3. 建议焊接温度不超过 350℃，时间不超过 3 秒；

4. 储存温度-25~40℃，晶片表面发黄可用橡皮擦拭即可去除，不影响其性能。